

# 経済産業省における半導体政策の動向について

令和8年2月26日

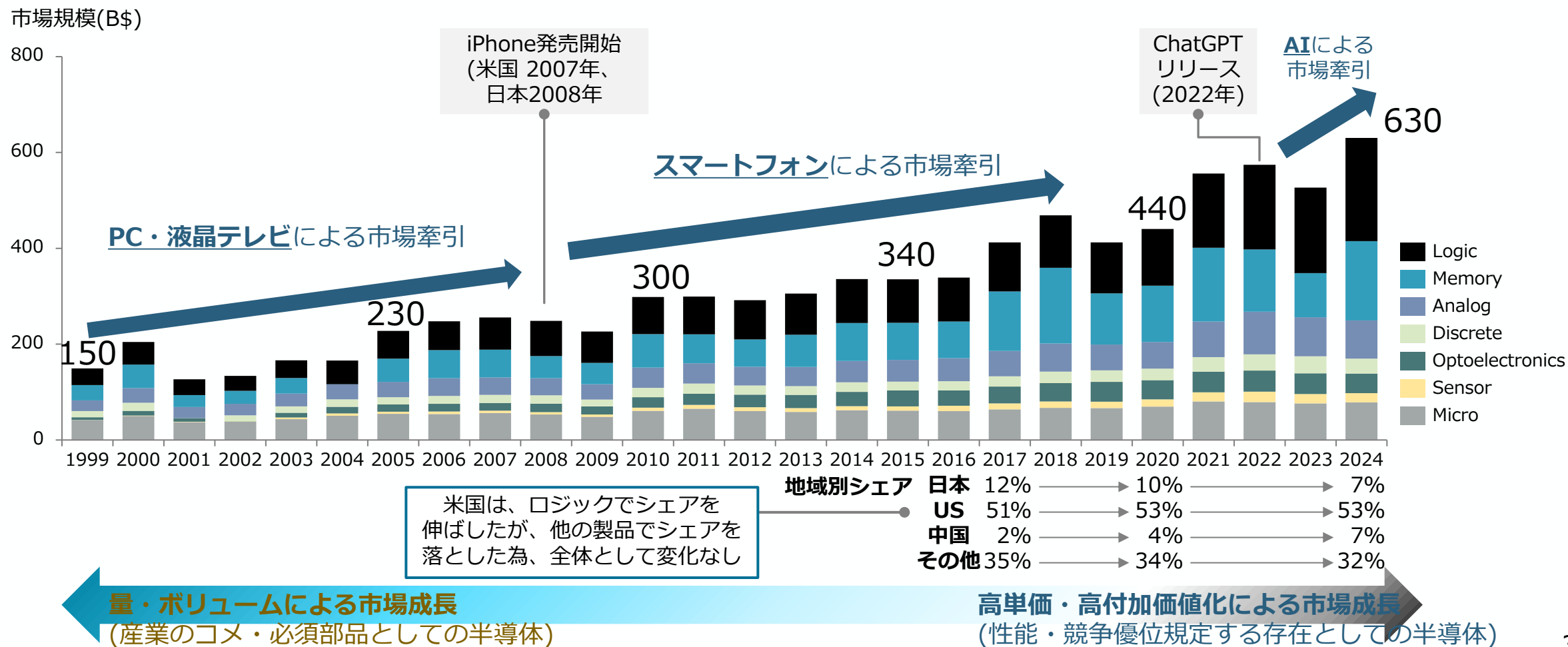
経済産業省 商務情報政策局 情報産業課

# 衆議院本会議における高市総理答弁（2026年2月24日）

- 半導体は、今後国内外において急速な市場拡大が見込まれており、**成長投資の要となる戦略分野**です。
- 政府としても、これまで、A I・半導体産業基盤強化フレームを策定し、事業者の予見可能性を確保しました。
- こうしたフレームも活用しつつ、**熊本のJ A S M(ジャスム)や北海道のラピダスなどについて、戦略的かつスピード感を持って取り組んでいます。**
- 先日、T S M Cのシーシー・ウェイ会長にお会いした際、高市内閣が、生成A I・自動運転・ロボティクス等の最先端技術への投資を促すのみならず、需要の喚起や人材育成にも積極的に取り組んでいることは、日本国内の半導体産業の成長に大きく寄与する、とのお話をいただきました。
- このような**A I・半導体投資は、スタートアップの創出や、熊本や北海道における半導体関連産業の集積など、地域経済にも大きく波及し、地域未来戦略における「産業クラスター」形成の軸になるもの**です。
- 今後、**官民投資ロードマップを、今夏の成長戦略のとりまとめに向けて、具体的にお示ししていく方針**です。
- その中には、A Iと半導体の戦略投資を一体的に拡大することにより、需要と供給の好循環を実現するなどの戦略を盛り込んでまいります。

# 半導体のこれまでの進化の歴史

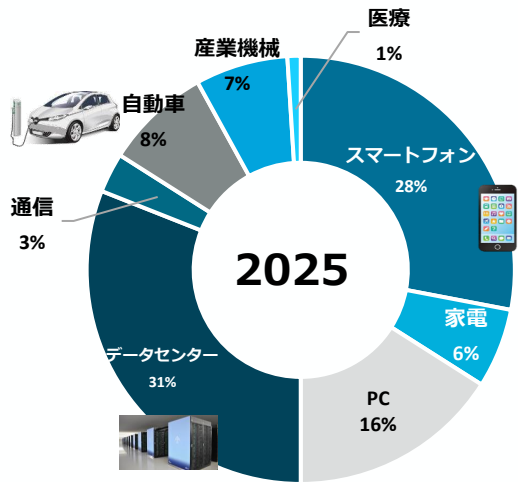
- 2022年のChatGPT登場以降、半導体成長の牽引役はAIへと移り、ロジックの比重も増加。
- 2025年現在は、AI主導の市場拡大フェーズの序章段階。



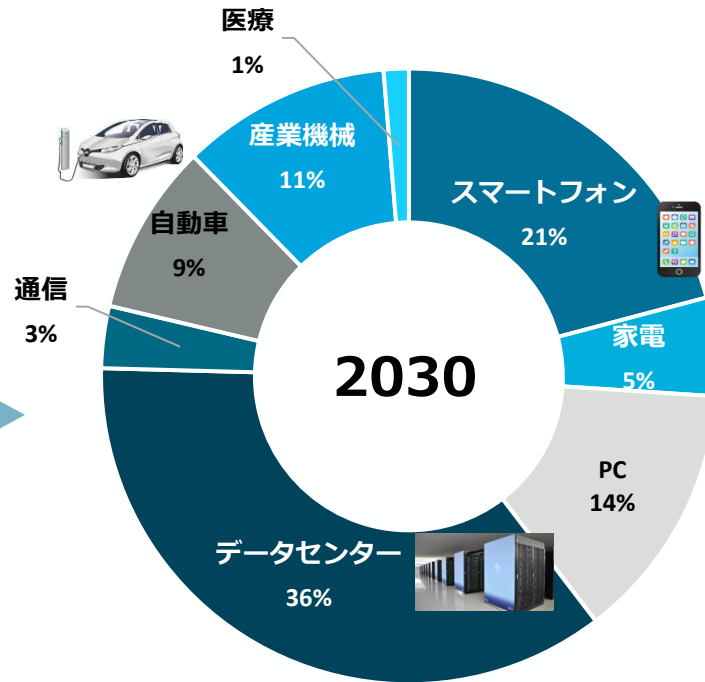
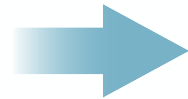
# 我が国半導体戦略の基本方針

- 2030年に、国内で半導体を生産する企業の合計売上高（半導体関連）として、15兆円超（※2020年現在5兆円）を実現し、我が国の半導体の安定的な供給を確保する。

## Step 1 : 半導体生産基盤強化 ⇒生産ポートフォリオの緊急強化



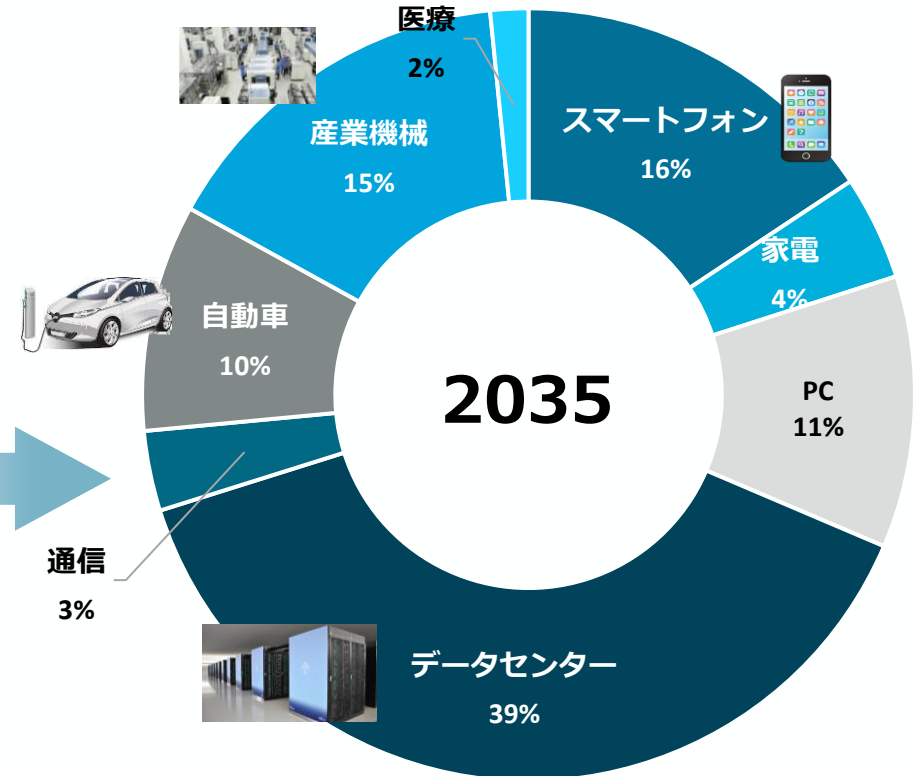
市場規模全体：約107兆円



市場規模全体：約139兆円

## Step 2 : 次世代半導体の技術確立

⇒グローバル連携による次世代半導体技術の習得・国内での確立



市場規模全体：約189兆円

## Step 3 : 将来技術開発

⇒光電融合技術など将来技術の実現・実装時期の前倒し

# AI・半導体産業基盤強化フレーム

- 2030年度までの7年間で**10兆円以上のAI・半導体支援を実施**し、これを呼び水に、今後10年間で50兆円を超える国内投資を官民協調で実現する（2024年11月22日閣議決定）。

（参考）これまでの予算額：7,740億円（FY2021）、約1.3兆円（FY2022）、約1.1兆円（FY2023）、約1.5兆円（FY2024）

## 支援規模

- **補助・委託等**  
**6兆円程度**

- 次世代半導体研究開発
- 半導体量産投資 等

- **金融支援（出資・債務保証等）**  
**4兆円以上**




- 次世代半導体量産投資
- AI利活用に向けた計算基盤整備 等



AI・半導体  
関連産業

# 先端半導体の製造基盤の整備

- 先端半導体の製造基盤整備への投資判断を後押しすべく、5G促進法およびNEDO法を改正し、令和4年3月1日に施行。同法に基づく支援のため、これまで計約2.2兆円を計上。
- 先端半導体の生産施設の整備・生産を行う計画につき、経済産業大臣による認定を7件実施し、ロジック半導体、メモリ半導体 (DRAM・NAND) の安定的な生産が着実に進展。

関連事業者				 <small>※2025年2月にWD社からフラッシュ事業を分離し Sandisk社が継承</small>				
認定日		①2022年6月17日	⑥2024年2月24日	②2022年7月26日	⑤2024年2月6日	③2022年9月30日	④2023年10月3日	⑦2025年9月12日
最大助成額		4,760億円	7,320億円	929.3億円	1,500億円	464.7億円	1,670億円	5,000億円
計画の概要	場所	熊本県菊池郡菊陽町	熊本県菊池郡菊陽町	三重県四日市市	三重県四日市市 岩手県北上市	広島県東広島市	広島県東広島市	広島県東広島市
	主要製品	ロジック半導体 (22/28nm・12/16nm)	ロジック半導体 (6nm・12nm・40nm) ※40nmは支援対象外	3次元フラッシュ メモリ (第6・8世代製品)	3次元フラッシュ メモリ (第8・9世代製品)	DRAM (1β世代)	DRAM (1γ世代) ※EUVを導入して生産	DRAM (次世代)
	生産能力 ※12インチ換算	5.5万枚/月	4.8万枚/月 ※40nmも含むと6.3万枚/月	10.5万枚/月	8.5万枚/月	4万枚/月	4万枚/月	4万枚/月
	初回出荷	2024年12月	2027年 10月～12月	2023年2月	2025年9月	2023年 6月～8月	2025年12月～ 2026年2月	2028年 6月～8月
	設備投資額 ※操業に必要な 支出は除く	86億ドル規模	139億ドル規模 ※40nmを除いた支援対象分 は122億ドル規模	約2,788億円	約4,500億円	約1,394億円	約5,000億円	約1.5兆円

※いずれも10年以上の継続生産

# 経済安保推進法に基づくこれまでの認定実績（半導体）

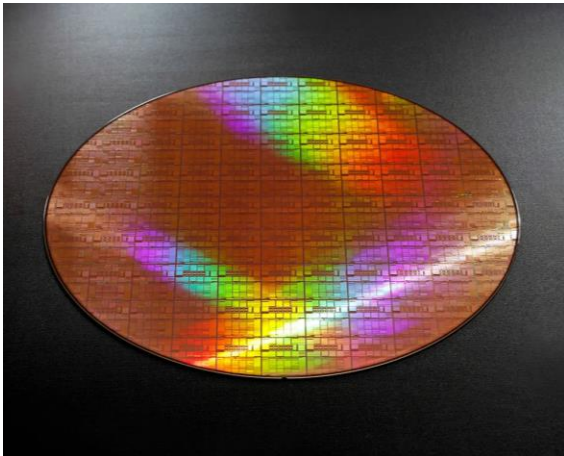
<認定案件一覧（※2025年9月12日時点）>

合計26件、**約4,259億円**

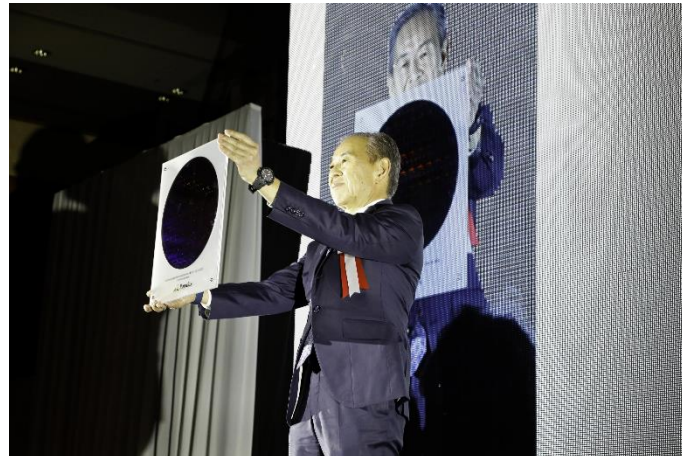
分類	事業者名	品目	投資場所	供給開始	事業総額 (億円)	最大助成額 (億円)
従来型 半導体	ルネサス	マイコン	茨城県ひたちなか市、山梨県甲斐市等	2025年3月	477	<b>159</b>
	ローム、東芝D&S	SiCパワー半導体、SiCウエハ、Siパワー半導体	宮崎県国富町、石川県能美市	SiC：2026年4月、Si：2025年3月	3,883	<b>1,294</b>
	富士電機、デンソー	SiCパワー半導体、SiCエピウエハ、SiCウエハ	長野県松本市、愛知県幸田町、三重県いなべ市	パワー半導体：2027年5月、 エピ：2026年9月、ウエハ 2026年9月	2,116	<b>705</b>
製造 装置	キヤノン	露光装置	栃木県宇都宮市、茨城県阿見町	2026年4月	333	<b>111</b>
	カナデビア（旧名：日立造船）	ラッピングプレート	福井県高浜町	2027年4月	27	<b>9</b>
	タキロンシーアイ	半導体製造装置向け樹脂プレート	兵庫県たつの市	2027年1月	44	<b>14</b>
	三井・ケマーズフロプロダクツ	半導体製造装置用樹脂	静岡県静岡市	2028年12月	-	<b>80</b>
部素材	イビデン	FC-BGA基板	岐阜県大野町	2025年9月	-	<b>405</b>
	新光電気工業	FC-BGA基板	長野県千曲市	2029年7月	533	<b>178</b>
	RESONAC	SiCウエハ	栃木県小山市、滋賀県彦根市等	基板：2027年4月、エピ：2027年5月	309	<b>103</b>
	SUMCO	シリコンウエハ	佐賀県伊万里市、佐賀県吉野ヶ里町	結晶：2029年10月、ウエハ：2029年10月	2,250	<b>750</b>
	東洋合成工業	感光材・ポリマー、高純度溶剤	千葉県東庄町、市川市、兵庫県淡路市	(高純度溶剤) 2027年9月 (感光剤ポリマー) 2029年4月	211	<b>70</b>
	三菱ケミカル	合成石英粉	福岡県北九州市	2028年9月	111	<b>37</b>
	JX金属	先端分野向け銅系スパッタリングターゲット	茨城県ひたちなか市	2029年4月	66	<b>22</b>
	DIC	半導体用エポキシ樹脂	千葉県市原市	2029年7月	90	<b>30</b>
	日東紡績	最先端ロジック IC 用途低熱膨張ガラスクロス	福島県福島市	2027年7月	72	<b>24</b>
原料	ソニーセミコン	ネオン（リサイクル）	長崎県諫早市等	2026年3月	7.0	<b>2.3</b>
	キオクシア	ネオン（リサイクル）	三重県四日市市等	2027年3月	8.3	<b>2.8</b>
	高圧ガス工業	ヘリウム（リサイクル）	-	-	-	<b>0.7</b>
	住友商事	黄リン（リサイクル）	宮城県仙台市等	-	-	<b>52</b>
	岩谷産業、岩谷瓦斯	ヘリウム（備蓄）	-	-	-	<b>10.5</b>
	JFEスチール、東京ガスケミカル	希ガス（生産）	-	-	-	<b>188.7</b>
	大陽日酸	希ガス（生産）	千葉県君津市等	-	-	
	日本エア・リキード	希ガス（生産）	-	-	-	
	ラサ工業	リン酸（リサイクル）	大阪府大阪市	2027年4月	-	<b>1.6</b>
エア・ウォーター、日本ヘリウム	ヘリウム（備蓄）	-	-	-	<b>7.2</b>	

# ラピダスの動向

- 2025年7月18日、国内外の顧客候補や取引先企業等を招き、顧客向けイベントを開催。
- 小池社長は、北海道千歳市の製造拠点IIMにおいて、2ナノ世代のトランジスタ（ゲート・オール・アラウンド（GAA）構造）の試作に成功し、動作を確認したと発表。
- 今後、量産化に向けた性能改善・歩留まり向上などの量産技術の確立に注力する方針。



2nmGAAトランジスタ  
試作ウェハ



ウェハを掲げる小池社長

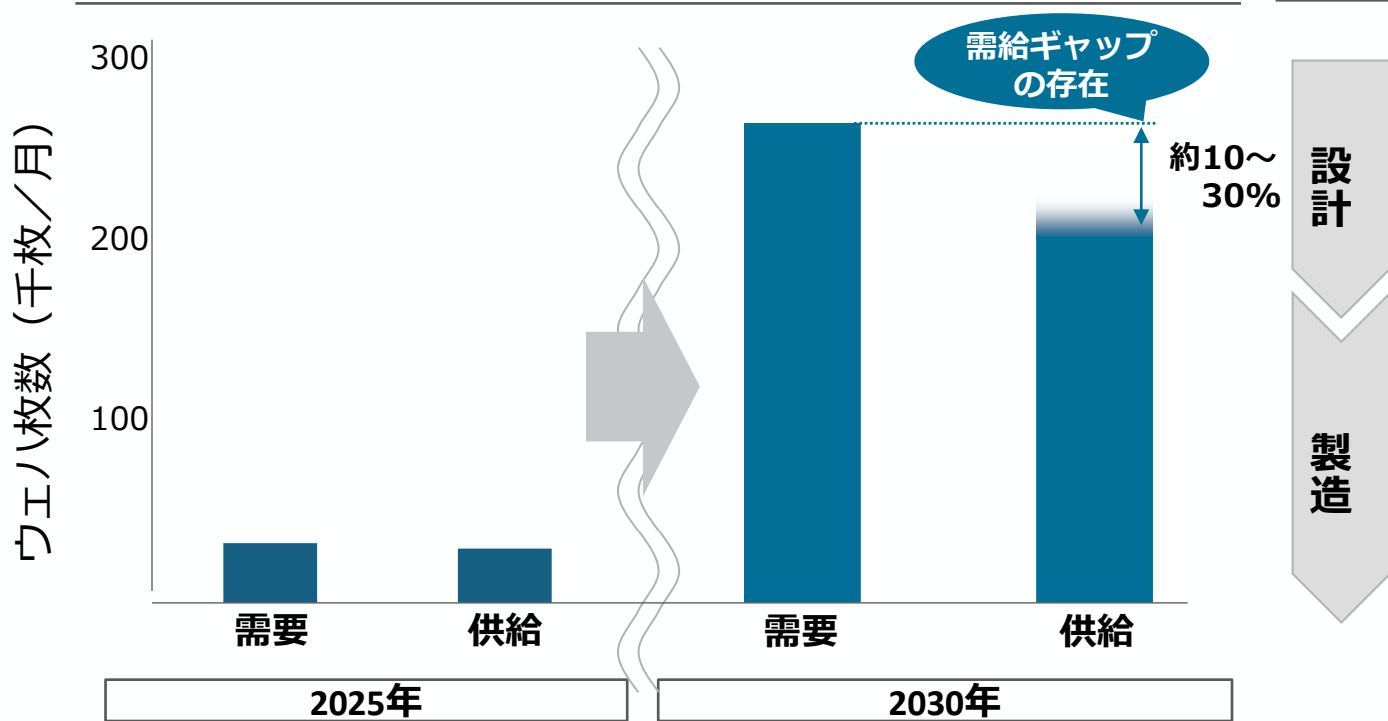


IIM外観  
(2025年7月18日時点)

# ラピダスの顧客獲得に関する取組

- 今後、AIデータセンター向け、エッジ端末向け（自動車、ロボティクス等）等を中心に次世代半導体のマクロ需要は大きく伸長。需要に対して供給が追いつかない状況が想定される。
- また、半導体製品は、先端製品ほど設計開発から製造まで多くのプロセスが必要となり、完成品を市場に投入するまでに一定の時間を要する。Rapidus社は枚葉方式や新たな方式の搬送システム等の差別化技術により、従来と比べ設計や試作改善・製造に要する期間を短期化することで、顧客の獲得を目指す。

2ナノ世代の需要・供給の想定（2025年、2030年）



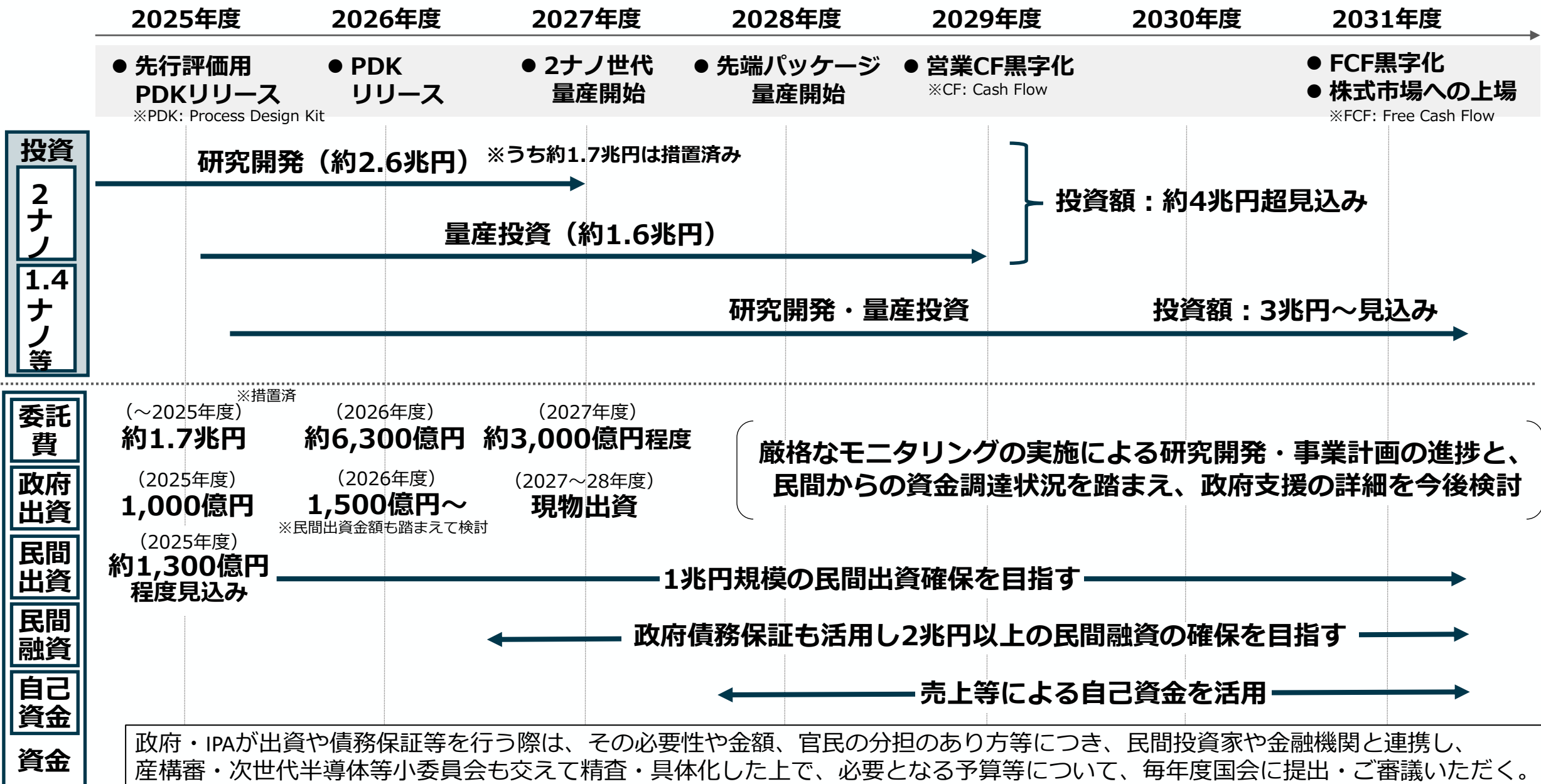
Rapidus社の開発・製造プロセス短縮の取組

- 前工程に加え、後工程向けの設計ツールやAIを活用した設計支援ツールを開発し、顧客へ提供
- 設計から製造までのプロセスで蓄積したデータを横断的に集約・分析・学習し、各工程にフィードバック。
- 多品種の製品を効率的に生産できる全枚葉式の製造プロセスを全工程で採用
  - プロセス間でウェハを効率的に搬送するため、新たな方式の搬送システムを導入

**設計や試作改善・製造の短期化により、  
カスタム半導体等を中心に顧客の獲得を目指す**

※出典：Semi, 300\_fab outlook-2025などを基にRapidus社試算（2025年時点の試算）  
（なお、他の複数ソースの分析においても同水準の需給ギャップの存在が報告されている。）

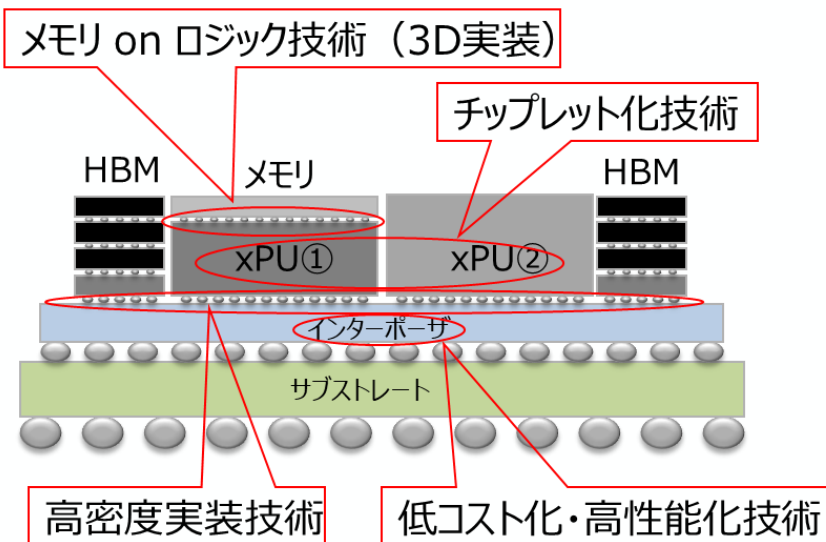
# Rapidus株式会社の投資計画・資金調達計画




政府・IPAが出資や債務保証等を行う際は、その必要性や金額、官民の分担のあり方等につき、民間投資家や金融機関と連携し、産構審・次世代半導体等小委員会も交えて精査・具体化した上で、必要となる予算等について、毎年度国会に提出・ご審議いただく。

# 先端半導体後工程の技術開発

- 先端パッケージ技術は、チップ間配線及び配線間接合の微細化や、パッケージ基板・インターポータの大型化が今後の競争力の源泉。
- Rapidusにより先端パッケージ設計・製造技術の開発を目指すとともに、国内材料・装置メーカーの競争力強化のために、TSMC、Samsung等とも連携したプロジェクトも実施。
- また、組立・検査に着目した完全自動化実現に向けた研究開発について、インテルや国内装置、部材メーカーが参加する半導体後工程自動化・標準化技術研究組合（SATAS）が実施。




**Rapidus**  
 (2024年4月2日採択公表)



- ◆ 先端パッケージの設計から製造技術に至るまで、北海道千歳市にパイロットラインを構築して量産・実用化を見据えて一貫して取り組む
- ◆ 米IBM, 独Fraunhofer, 星IMEと連携して進める


**TSMCジャパン3DIC  
 研究開発センター**  
 (2021年5月31日採択公表)



- ◆ 産総研（つくば）にパイロットラインを構築
- ◆ 我が国の材料・装置メーカーと連携して、技術開発に取り組む


※研究開発事業は2025年12月まで

**半導体後工程自動化・標準化  
 技術研究組合（SATAS）**  
 (2024年11月6日採択公表)



- ◆ 組立・検査に着目し、完全自動化に必要な装置・システム間の標準インターフェース開発に取り組む
- ◆ 米インテル、国内の装置・部材メーカーが参画





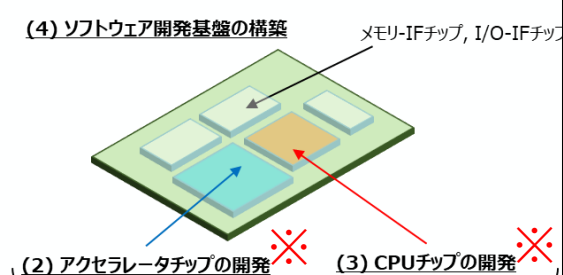
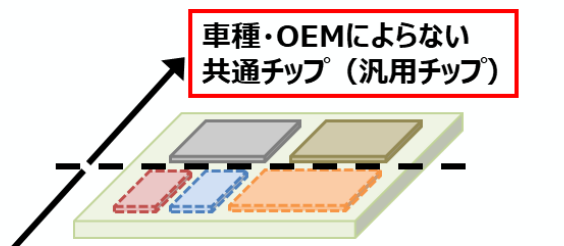
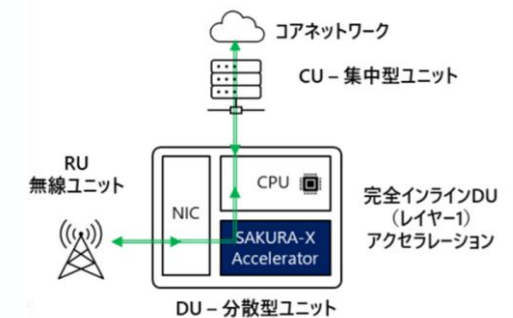
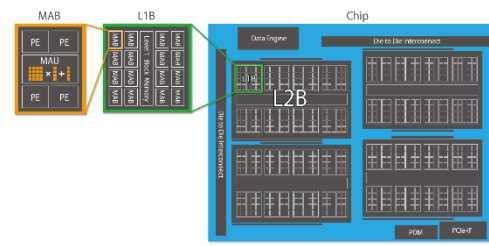
**日本サムスン SAMSUNG**  
 (2023年12月21日採択公表)



- ◆ みなとみらいにパイロットラインを構築
- ◆ 3.xDチップレット技術の実現に向けて国内の材料・装置メーカーと緊密に連携して開発を行う

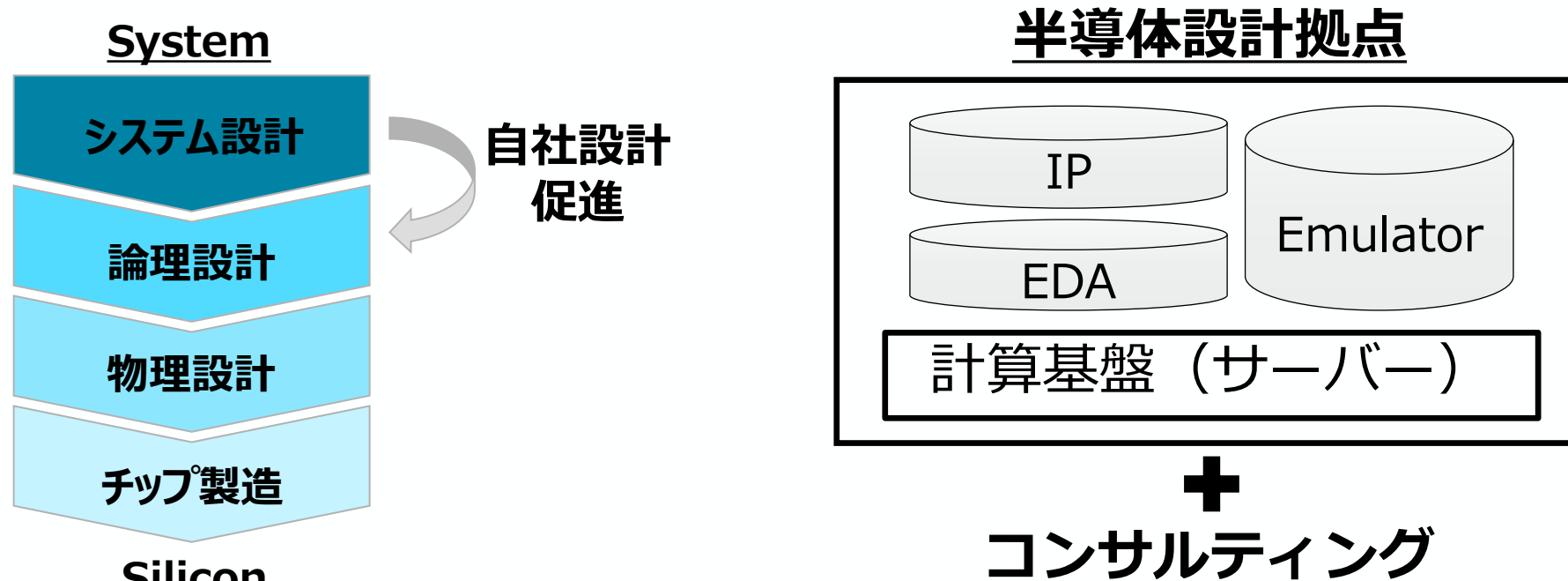
# 次世代半導体設計開発

- これまで、LSTCと米Tenstorrent社の連携によるエッジAI半導体開発、トヨタ・ホンダ・日産など国内車両メーカーを中心とした技術研究組合ASRAによる自動車向け最先端半導体開発を実施。
- 2024年11月、EdgeCortix社による通信用AI半導体を採択し、次世代5G基地局の分散型ユニット（DU）の高性能化・低消費電力化に資する半導体設計プロジェクトを開始。
- Preferred Networks社においては、AI用計算資源に特化したAI半導体の開発を進め、データセンターの高効率化、省電力化を目指す。

<p>実施 機関</p>		 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 車両メーカー：トヨタ、ホンダ、日産、スズキ、スバル、マツダ</li> <li>● 電装部品メーカー：デンソー、Astemo、パナソニック</li> <li>● 半導体メーカー：ルネサス、ソシオネクスト、ミライズ、シノプシス、ケイデンス</li> </ul>		
<p>内容</p>	<p>エッジ向けのAI半導体</p>  <p>※Rapidus 2nmチップ</p>	<p>自動運転向け最先端半導体</p>  <p>車種・OEMによらない 共通チップ（汎用チップ）</p> <p>車種毎・OEM毎に 競争力を持たせるチップ（差別化チップ）</p>	<p>通信用AI半導体</p>  <p>次世代5Gの仮想O-RAN環境に展開され、生成AIアプリケーションと低消費電力の分散型ユニットアクセラレーションの両方を同一ハードウェア上でサポートする</p>	<p>計算資源用AI半導体 (MN-core)</p>  <p>MN-Coreは構造が単純であることから実行可能な処理は限られるが、決められた処理は高効率・省電力に実行可能。AIの計算プロセスに特化させることで、高効率化・省電力化を目指す</p>

# 半導体設計拠点の整備に向けての方向性

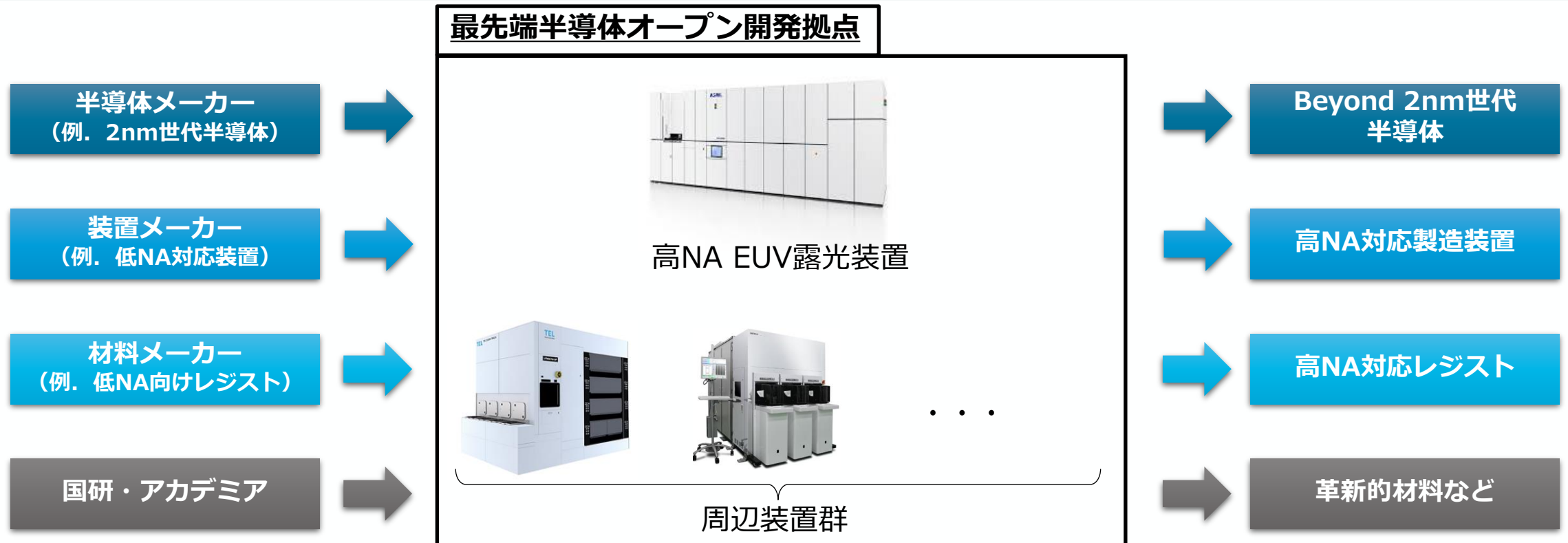
- かつて我が国が半導体で世界シェアトップだった頃は、国内にシステム・サービス事業者が多数存在し、各社自社システム・サービス・製品向けの半導体を自社で設計・製造を行っていた。
- 昨今も、GAFAM中心として、自社のAIやサービスの競争力強化のために、半導体を自社で設計する傾向であるが、我が国産業においては、半導体は自社で設計する基幹部品という位置づけから、外部から調達する部品へと変わってしまった。
- 我が国システム産業の競争力強化のためには、自社で半導体を設計する“System to Silicon”を再び主導するような取組が必要。
- そのため、EDAやIP、エミュレータ等の半導体設計環境についてシステムOEM、スタートアップ、アカデミア等に提供するとともに、設計コンサルティングについても実施する半導体設計拠点を整備する。



# 最先端半導体オープン開発拠点

- **“High-NA”（※）と呼ばれる現行のEUV露光装置よりも更に微細な露光が可能な装置が、今後使われる予定。当該装置をオープン研究開発拠点に整備。**
- **半導体製造・製造装置・部素材企業や国研・大学が当該拠点を利用**すること想定しており、海外の企業・研究機関とも連携して**イノベーションの活性化**を目的としている。
- 拠点は、ラピダスが立地する美々ワールドを念頭に、北海道千歳市内を予定しており、最先端半導体の産業エコシステムを構築し、**稼働は2029年度を想定**。

（※）現行のEUV露光装置に比べて光学系が進化しており、より微細なパターンを露光可能な装置



- 「強い経済」を実現するためには、中長期的に企業の研究開発投資の増加を促し、国際的に遜色のないイノベーション立地競争環境を確保する必要がある。
- このため、計画認定制度に基づき、AI・量子・バイオ等の我が国の戦略技術領域について、①事業者自らの研究開発を促進する「戦略技術領域型(控除率40%)」、②そのうち、特に高い研究力等を持つ認定研究拠点とのオープンイノベーションを促進する「大学拠点等強化類型(控除率50%)」を創設するとともに、③「戦略技術領域型」(「大学拠点等強化類型」を含む)に対する「繰越税額控除制度(3年間)」を創設する。また、研究開発投資をより促し、足元の物価上昇への対応なども含めた見直しを行った上で、時限措置の適用期限を3年間延長する。

## 改正概要

### ① 戦略技術領域に係る研究開発への重点化 (令和9年度から)

1. 「戦略技術領域型」の創設 (控除上限別枠10%。2.を含む)  
事業者が自ら実施する戦略技術領域の研究開発に40%の控除率を措置
2. (1.のうち)「大学拠点等強化類型」の創設  
事業者と特に高い研究力等を持つ認定研究拠点とのオープンイノベーションに50%の控除率を措置
3. 「繰越税額控除制度」の創設  
予見可能性の向上や国際的な競争力確保の観点から、戦略技術領域型、大学拠点等強化類型について、3年間の繰越控除を措置

＜戦略技術領域＞：以下の領域における特に早期の企業化が期待される技術

- ① AI・先端ロボット      ② 量子      ③ 半導体・通信
- ④ バイオ・ヘルスケア      ⑤ フュージョンエネルギー      ⑥ 宇宙

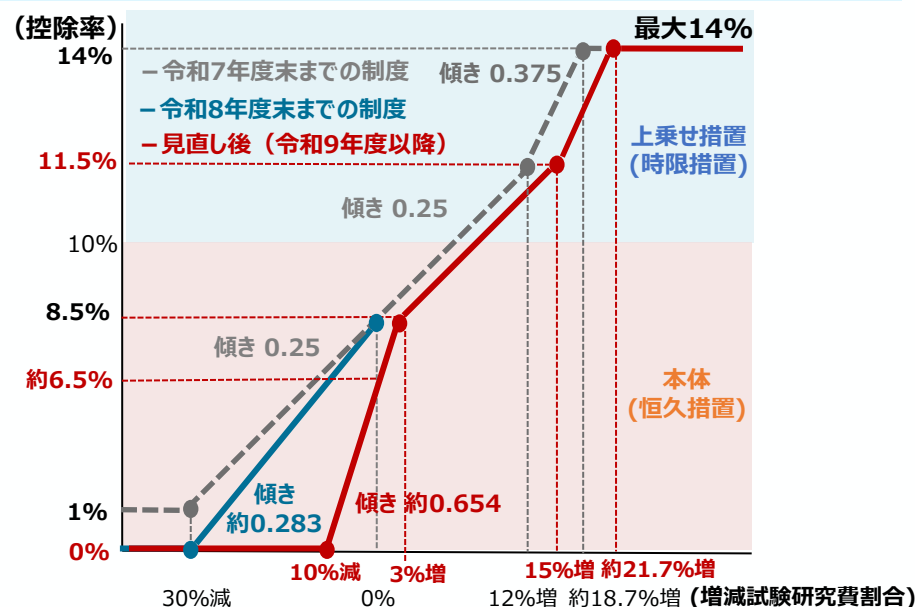
### ② オープンイノベーション型の見直し (令和8年度から)

＜オープンイノベーション型＞

- 経済産業大臣の指定を受けた大学等との共同・委託研究について、第三者による監査を不要とする合理化
- 高度研究人材の定義を拡充※、研究テーマの公募要件を緩和  
※博士号取得後5年未満の者を採用後5年間を拡充

### ③ 研究開発投資をより促すため等の見直し

1. 研究開発投資をより促し、足元の物価上昇への対応



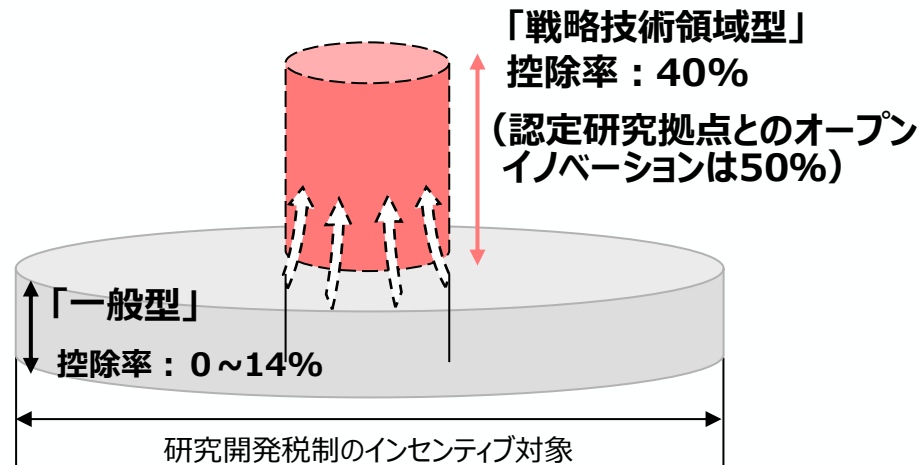
2. 国内の研究人材や研究開発拠点の維持・強化 (令和8年度から) 海外への委託研究費について、新医薬品等の有効性及び安全性の確認のために行う臨床試験に係るものを除き、令和8年度70%、令和9年度60%、令和10年度以降50%、と段階的に見直し

## (参考) 「戦略技術領域型」「大学拠点等強化類型」の創設

- 「強い経済」を実現する上で、**戦略的に重要な技術領域の研究開発投資への重点化**が必要。
- このため、戦略技術領域の研究開発に対して以下の措置を講ずる。【適用期限：令和10年度末まで※】
  - ① 事業者が、認定計画に基づき自ら実施する戦略技術領域の研究開発について、その**試験研究費の40%**を法人税額から控除（「戦略技術領域型」の創設）
  - ② ①のうち、事業者が、認定計画に基づき認定研究拠点と実施する共同・委託研究開発について、その**試験研究費の50%**を法人税額から控除（「大学拠点等強化類型」の創設）
- **「戦略技術領域型」（「大学拠点等強化類型」を含む）に対する控除上限は法人税額の10%**。控除しきれない分は**3年間の繰越**（研究開発を増やした年に利用可）を措置。

※令和10年度末までに認定を受けた計画に対して、認定日から最大5年間適用。

### 戦略技術領域型のイメージ



### 戦略技術領域：以下の領域における特に早期の企業化が期待される技術

- ① AI・先端口ロボット
- ② 量子
- ③ 半導体・通信
- ④ バイオ・ヘルスケア
- ⑤ フュージョンエネルギー
- ⑥ 宇宙

# (参考) オープンイノベーション型の手続き合理化、高度研究人材の活用の拡充

- 産学連携、博士号取得者の産業界での活躍を強力に後押し。オープンイノベーション型について、以下を措置する。
  - ① 大学等との共同・委託研究の手続き合理化：  
一定の要件を満たし、経済産業大臣の指定を受けた大学等との共同・委託研究については、第三者による監査を不要とする。
  - ② 高度研究人材の活用の拡充：  
高度研究人材の定義の拡充及び研究テーマの公募要件の緩和を行う。

## ①大学等との共同・委託研究

- 対象となる研究費の監査

	改正前	改正後(※)
大学等の手続き	大学等の確認	大学等の長(本部)の認定
税理士・会計士等の監査	<b>要</b>	<b>不要</b>

※大学本部の体制など一定の要件を満たし、経済産業大臣の指定を受けた大学等が対象



**企業・大学等の手続きを合理化**

## ②高度研究人材の活用

- 高度研究人材の定義

博士号取得から5年未満  
**又は**  
**上記の者を採用してから5年間(拡充)**

- 研究テーマの公募要件(提案者の範囲)

改正前

高度研究人材

**拡充**

改正後

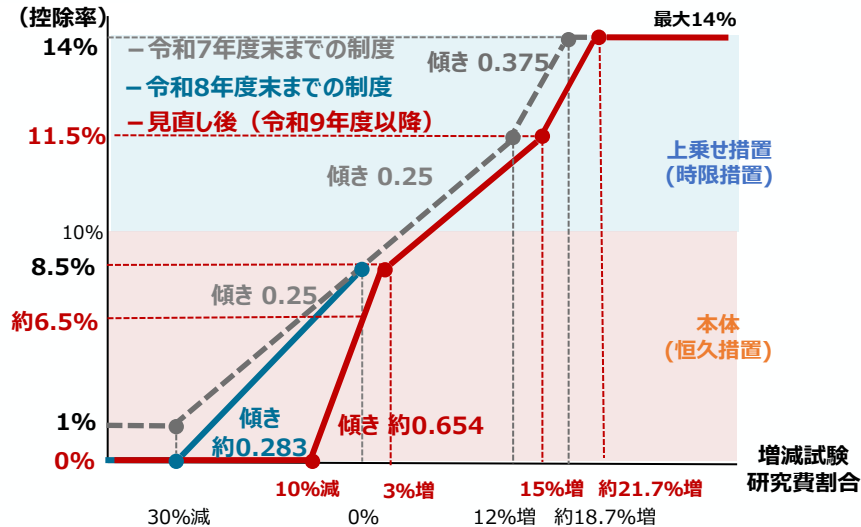
高度研究人材  
**を含む使用人**

# (参考) 研究開発投資をより促すため等の見直し (一般型、海外委託費)

- 研究開発投資をより促し、足元の物価上昇へ対応するため、**控除率**を見直すとともに、試験研究費の増減割合に応じて**控除上限が変動する制度**も同様に見直す。
- その上で、**時限措置 (控除率の上限引上げ、控除上限・控除率の上乗せ措置)**について、**適用期限を3年間延長**する。
- 加えて、海外への委託研究費について、**国内の研究人材や研究開発拠点の維持・強化の観点から**、海外で行う治験※を除き、**令和8年度から段階的に見直す**。

※医薬品、医療機器又は再生医療等製品の有効性及び安全性の確認のために行う臨床試験 (科学的な質及び成績の信頼性が確保されているものに限る。)

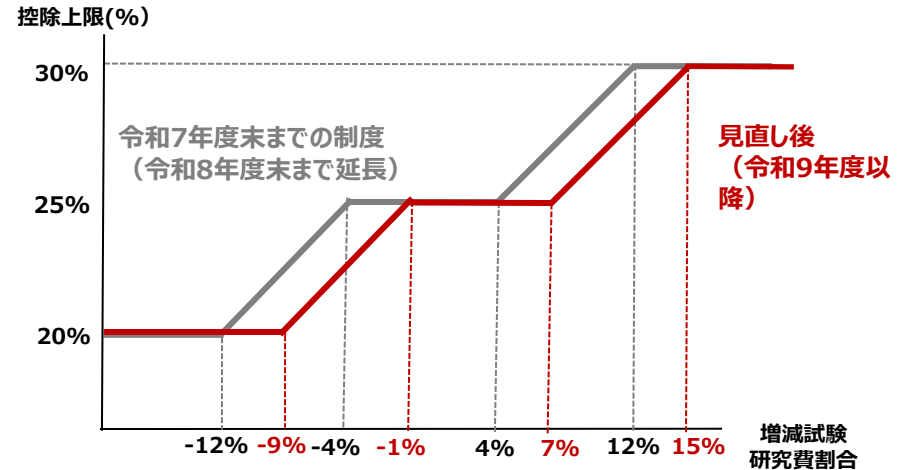
## ① 控除率の見直し



### 【時限措置の延長】

- (1)控除率の上限について、一般型10%→14%とする特例について、**適用期限を令和10年度末までの3年間延長**
- (2)試験研究費割合10%超の場合の控除上限・控除率の上乗せ措置について、**適用期限を令和10年度末までの3年間延長**

## ② 控除上限の見直し



## ③ 海外委託費の見直し

新医薬品の有効性等の確認の臨床試験の海外委託	左記以外の海外委託
100分の100	令和8年度：100分の70 令和9年度：100分の60 令和10年度：100分の50

# 大胆な投資促進税制の創設 (法人税・所得税・法人住民税・事業税)

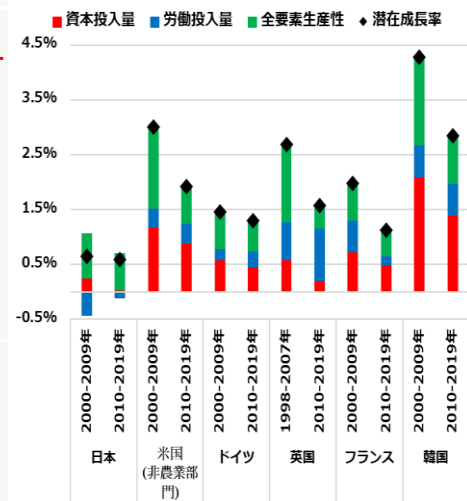
新設

- 国内投資の拡大を通じて、日本企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、高付加価値化のための**大胆な設備投資を促進する税制（建物を含む即時償却や税額控除7%等）を創設**する。

2030年度135兆円、2040年度200兆円の官民目標実現に向け、国内投資を拡大。（2024年度は106兆円）

対象業種	<b>原則全ての業種を対象</b>
対象資産要件	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>生産等に必要な設備等（機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設備、ソフトウェア）</b></li> <li><b>投資下限額：35億円以上（中小企業者等については5億円以上）</b> ※投資計画期間中の総額</li> <li><b>ROI水準：15%以上</b></li> </ul>
措置内容	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>即時償却または税額控除7%（建物、建物附属設備及び構築物は税額控除4%）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>控除上限：法人税額の20%</li> </ul> </li> <li><b>事業環境の急激な変化による影響への対応（繰越税額控除）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について、法律に基づく認定を受けた事業者については、<b>繰越税額控除（3年間）が可能。</b></li> </ul> </li> </ul>
措置期間	<b>令和11年3月31日までの間に設備投資計画につき、法律に基づく確認を受けた者が、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等をし、事業の用に供した設備等を対象。</b>

潜在成長率の各項目寄与度の比較



各国の投資促進策の動向

- 日本** ● **大胆な投資促進税制を創設。**
- 米国** 🇺🇸
  - 2025年7月に成立したOBDD法において、米国内での設備投資に対して**即時償却措置を恒久化しつつ、その対象に建物を追加（建物は時限措置）。**
- ドイツ** 🇩🇪
  - 2025年7月に成立した減税法において、**設備投資償却率を最大30%に引き上げつつ、2028年より法人税率を1%ずつ5年間引き下げ予定（実施後は24.9%）。**

**新たな設備投資税制への期待**

※経産省から企業へのヒアリングより抜粋  
 <海外投資→国内投資>

- 電子部品製造  
 「海外立地か国内立地かの判断に**必要不可欠**」
- 自動車  
 「関税の逆境下での国内投資の維持・拡大に**極めて有効**」

<投資規模小→投資拡大・実現>

- 造船  
 「回収に長期を有する**大規模投資の判断が可能**」
- 半導体部品  
 「短期の投資サイクル競争の中での**生き残りの支えになる**」
- コンテンツ  
 「高い措置率の税額控除により、**投資収益率が改善し、投資が可能**」